

bearbeitete und abgeschlossene
Förderungsprojekte

1. Project “Berolina”, Humboldt-University of Berlin:
Crystal Growth under Microgravity on Board of the Space Station Salut-3/Russia with the first German astronaut S. Jähn, 1977-1979:
1. PbTe growth from vapour, 2. PbTe Bridgman growth, 3. Bi-Sb shaped crystal growth, 4. Bi-Sb Bridgman growth.
2. Industrie-Wissenschaftsprojekt IR-Strahlungsdetektoren, Humboldt Universität zu Berlin, subcontract (Hg,Cd)Te Material Research, 1985-1989:
Part I: Purification, Synthesis, Growth and Crystal Preparation; Part II: Annealing
3. DFG-Projekt, Humboldt-University Berlin, 1991-1992:
Optische Störstellendefektanalyse von CdTe-Einkristallen gezüchtet nach der Bridgmanmethode [optical point defect analysis of CdTe single crystals grown by the Bridgman technique].
4. Volkswagen-Project, No I - 65988, Humboldt-University Berlin and Albert-Ludwigs-University Freiburg, 1992-1993:
Vergleichende experimentelle und theoretische Untersuchungen zum Wärme- und Materialtransport bei der Kristallzüchtung von Verbindungshalbleitern [comparative experimental and theoretical researches on heat and mass transfer at crystal growth of compound semiconductors] (52 pages).
5. DFG-Project No. RU 505/3-1, Humboldt-University Berlin, October 1992 - September 1994:
Züchtung von CdTe und CdZnTe-Substratkristallen mit definiert verbesserten Eigenschaften [Crystal growth of CdTe and CdZnTe].
6. Japanese industrial project, founded by Nihon Kessho Kogaku Co., Ltd. and Furukawa Co., Ltd P., IMR Tohoku University Sendai/Japan, September 1993 - September 1994:
Growth of Shaped CdTe Crystals with High Electrical Resistivity by Casting and First Test of Radiation Detector Parameters.
7. DARA Project No 50 WM 9223, Humboldt-University of Berlin, January 1993 – December 1994:
Lösungszonenzüchtung von (Cd,Zn)Te [solution zone growth of CdZnTe].
8. BMBF - Project, No 01 BM 501, Institut für Kristallzüchtung Berlin, March 1995 - November 1998:
Versetzungarme GaAs-Einkristalle mittels VCZ-Methode [Dislocation-reduced GaAs single crystals grown by the VCZ method].

9. BMBF – Projekt, No. 01 BM 501/A0, Institut für Kristallzüchtung Berlin, August 1998 – July 2002:
Entwicklung eines VCz-Züchtungsverfahrens für 150 mm SI GaAs-Kristalle [Development of a VCz-Method for 150 mm SI GaAs Crystals] (58 pages).
10. DFG-Projekt RU 505/10-1, -2, -3, Institut für Kristallzüchtung Berlin, 2004 - 2008:
Point defect analysis in GaAs crystals.
11. Projekt-Unterauftrag FCM-SAB-8372, IKZ Berlin, 03. 07. 2007:
Strukturbildung von Versetzungen in GaAs [structural patterning in GaAs].
12. Industrieprojekt CaliSolar Berlin, M-Cz Si, 2008 - 2010:
Czochralskizüchtung von Si im Magnetfeld [Cz growth in magnetic field].
13. TSB, ZAB-gefördertes Projekt, EFRE -Finanzierungs Nr. 10125968 and 10130418, 01.07.2005 – 30. 06. 2008, IKZ Berlin, WIAS, Stremat, Auteam:
KRISTMAG – Kristallzüchtung im wandernden Magnetfeld (Crystal Growth in Magnetic Field).
14. TSB, ZAB-gefördertes Projekt, EFRE-Finanzierungs Nr. 10138496, 01.07.2009 - 30. 06. 2011, IKZ Berlin, WIAS, Steremat, Auteam, SChOTT Wafer Solar:
AVANTSOLAR - Anlagen- und Verfahrensentwicklung sowie Absatz einer Neuen Technologie zur Kristallisation von Solar-Silicium [New technology of crystallization of mc-Si].